

論文 / 著書情報
Article / Book Information

論題(和文)	電界誘起光第2次高調波法による有機半導体のキャリア挙動の解析技術
Title(English)	
著者(和文)	田口大, 間中孝彰, 岩本光正
Authors(English)	Dai Taguchi, Takaaki Manaka, MITSUMASA IWAMOTO
出典(和文)	光学, 44, 3, 111-118
Citation(English)	, 44, 3, 111-118
発行日 / Pub. date	2015, 1
URL	http://myosj.or.jp/publication/kogaku/backnumber/44-3/
権利情報 / Copyright	本著作物の著作権は日本光学会に帰属します。 Copyright (c) 2015 Society for The Optical Society of Japan.
Note	このファイルは著者(最終)版です。 This file is author (final) version.

電界誘起光第二次高調波法による有機半導体のキャリア挙動の解析技術

田口 大・間中 孝彰・岩本 光正*

*東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻

〒152-8552 東京都目黒区大岡山2-12-1

Analysis of Carrier Behaviors in Organic Semiconductors by Electric Field Induced Optical Second Harmonic Generation

Dai TAGUCHI, Takaaki MANAKA and Mitsumasa IWAMOTO*

*Department of Physical Electronics, Tokyo Institute of Technology,

2-12-1 O-okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8552

E-mail: iwamoto@pe.titech.ac.jp

Synopsis

A novel electric-field induced optical second harmonic generation (EFISHG) technique that can directly probe carrier behaviors in organic semiconductors is introduced. Nonlinear polarization generated in semiconductors by laser irradiation, in the presence of static electric field caused from mobile carriers, is probed along with the carrier motion. This technique is very helpful to analyze and model carrier dynamics in a variety of organic devices such as Organic solar cells. The principle of the EFISHG technique is described with some experimental examples on organic solar cells, and the future scope is briefly discussed.

Key words: Optical second-harmonic generation, Nonlinear polarization, Maxwell-Wagner effect, organic solar cell, semiconductor

和文要旨

有機半導体内にはガウスの法則に従ってキャリアにより電界が形成される。このとき、レーザー光照射をすると新たに非線形分極が生じ、電界誘起光第二次高調波が発生する。そのため、この光第二次高調波を観測することで、有機半導体内のキャリア挙動を直接観測・解析できる。この方法を用いれば、有機太陽電池ほか様々なデバイス中のキャリア挙動が評価できる。非線形分極の発生は材料に依存し、その大きさは照射するレーザー波長に依存するため、積層構造やバルクヘテロ構造の太陽電池内の特定の有機半導体を選択してキャリア挙動を解析できる。本解説記事では、電界誘起光第二次高調波法の測定原理とその解析例を、太陽電池を中心に紹介する。

はじめに

有機半導体デバイスの研究は、高移動度有機材料の開発と発見とともにある。そして、有機材料開発の過程は、絶縁・誘電材料から導電材料への流れでもある。したがって、現在、有機半導体デバイスの中で用いられている有機半導体材料は、「絶縁体・誘電体」をルーツとするものであるという視点に立ち、キャリアの輸送を観測・解析する手法を開発することは、ごく自然のことであろう^{1~3)}。絶縁・誘電材料では、材料自身のキャリア密度は低い。また、外部から注入された電荷は動きにくく、材料中に留まる。そのため、注入された電荷を源として「空間電荷電界」が形成され、様々な誘電・絶縁現象が引き起こされると考える。ゆえに、「電界」に着目し、「電界」や「電界」によって引き起こされる電気現象を計測することが、誘電・絶縁材料内のキャリアの挙動を探求する方法の基本となる⁴⁾。一方、有機トランジスタ、有機EL、有機太陽電池などでは、用いられる有機半導体材料内をキャリアが移動することがデバイス動作の根本である。したがって、「キャリアの移動」、すなわち「電流」を計測することが、有機デバイス内のキャリア挙動を探求する方法の基本となる。以上のように、誘電・絶縁材料と有機半導体材料では、キャリアについての着眼の仕方は異なる。しかし、誘電・絶縁材料も有機半導体材料も電気現象の源は、いずれも電荷を持った電子・正孔である。したがって、有機半導体デバイスのキャリアダイナミクスについても、キャリアが作る「電界」に着目し、その挙動を探求する方法がありうるということである。とくに、有機材料開発の過程が、絶縁・誘電材料から導電材料へと連続的に流れているものとするれば、いつでも同じ手法によって材料内のキャリア挙動が解析できるということは魅力である。

そこで、筆者らは、キャリアの作る「電界」に着目し、有機デバイス内のキャリア挙動を、光学的手法である電界誘起光第二次高調波 (EFISHG) 法によって評価する手法を開拓してきた^{4~7)}。この手法は、方法論からすると、誘電・絶縁材料物性の理解の基本となる分極現象という側面を通じて、有機デバイス中の電荷のダイナミクスを解析するというものである。

有機デバイスには、有機FETや有機EL、有機太陽電池など様々なものがあるが、これらはいずれも「キャリアの移動」無くしては動作しない。したがって、開発した手法は、有機デ

バイス全般のキャリア挙動の解析に適用できる。もちろん、絶縁体・誘電体のようにキャリアが注入後にトラップされ、静止しているような状態もあるが、こうした場合でも、トラップ電荷分布などについての情報が得られる。以上のように、EFISHG法とは、光学的手法を通してデバイス中のダイナミックなキャリア挙動などの電気現象を評価する新規な方法である^{5~7)}。

1. EFISHG 光の発生とキャリア

物質に光が入射すると、光の電場と物質中の電子との相互作用により以下のように振動分極が誘起される。

$$P_i = \chi_{ij}E_j + \chi_{ijk}E_jE_k + \chi_{ijkl}E_jE_kE_l + \dots \quad (1)$$

ここで、 χ は感受率、 E_n ($n = j, k, l$) は光の電界である。図1に示すように静的な電界 $E(0)$ があると、正負電荷は互いに逆方向に変位するため電子雲の対称性が崩れ、(1)式の第3項により入射光の2倍の周波数 2ω をもつ電界誘起SHG (electric-field-induced optical second-harmonic generation: EFISHG) が発生する。この場合のSHGの強度 $I(2\omega)$ は、レーザー光の電界 $E(\omega)$ や静電界 $E(0)$ 、非線形感受率 $\chi^{(3)}$ を用いて、

$$I(2\omega) \propto \left| \chi^{(3)} : E(0)E(\omega)E(\omega) \right|^2 \quad (2)$$

と書ける。(2)式より、EFISHGは、静的な電界 $E(0)$ がある場合にのみレーザー光照射によって発生する。したがって、EFISHG光の強度を測定し解析すれば、静電界の情報が得られる。

ガウスの法則によれば、誘電率 ϵ の有機材料内に過剰な電荷密度 ρ_s がある場合、

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho_s / \epsilon \quad (3)$$

を満たす電界 \vec{E} が形成される。そのため、材料内に過剰な電荷が侵入したり、エキシトンの乖離により正負の電荷が引き離されると、こうした電荷から(3)式にしたがって電界が発生し、

電荷の周りにある分子の電子雲を歪め、レーザー光を照射したとき(2)式の電界 $E(0)$ として非線形分極発生の源となりうる。そして、この非線形分極が起点となって発生するEFISHGは、材料固有の吸収波長に対応して共鳴増強を起こすため、入射光の波長を適宜選択することにより、多層膜中の特定の層を走行するキャリアの挙動が計測できるという可能性がある。

そこで以下では、まず、代表的なキャリア挙動の計測として横型の有機FET内の半導体層を輸送するキャリアについて述べる。ついで、有機太陽電池の例を取り上げる。いずれのデバイスにおいても、波長選択性という特徴が十分に発揮され、有機デバイス中の特定の有機半導体材料中のキャリア挙動が解析できる。

2. マックスウェル・ワグナー効果と界面の働き

有機FETや有機太陽電池の動作を考える上で、界面の働きを理解する必要があることは言うまでもない。有機FETではゲート絶縁層と有機半導体層の間に、また、太陽電池では2層の有機層の間や異種有機分子の間に界面がある。こうした界面の働きはそれぞれのデバイス機能を律する重要な役割を担っている。一方、EFISHG法を用いたキャリア挙動の計測という視点からは、こうした界面の存在を、電界を発生する起点となりうるかという視点から見ておく必要がある。有機FETでは、半導体とゲート絶縁層の界面にキャリアが集められてゲート層へのキャリアの移動を遮断している。一方、有機太陽電池では、界面はエキシトンが乖離する位置としての役割などを担っているとされる。したがって、界面はキャリアを起点とする電界が生ずる場所とみなすことができる。

ところで、電磁気学的にみれば、界面とは巨視的物性量である誘電率 ϵ と導電率 $\sigma_s = en\mu$ (n :キャリア密度、 μ :ドリフト移動度)の異なる物質の境界ということである。言い換えると、誘電率 ϵ と導電率 σ_s の比 $\tau = \epsilon/\sigma_s$ の値が異なる物質の境界ということである。 τ は緩和時間と呼ばれ、材料中での過剰キャリアが拡がる時間の目安となる量である^{2,3)}。導電率の小さな絶縁体の τ は長く、導電率の大きな導体の τ は短い。有機デバイスは、いわば、こうした τ の異なる材料の組み合わせである。すなわち、有機デバイスでは、金属—有機材料、異種有機

材料界面、異種分子界面など、いたるところにある界面が巧みに利用されている。そこで、緩和時間 τ は物質に固有な値を持つことから、緩和時間 τ の異なる材料の界面で起きる一般的な電気現象にまず注目する。実は、緩和時間の異なる材料界面を電流が横切って流れるとき、その界面には必ず電荷が蓄積される（マックスウェル・ワグナー効果）という一般的な法則がある^{1~3,6,7)}。すなわち、2つの物質界面を電流密度 j の電流が横切って流れるとき、2つの物質の緩和時間の差 $\Delta\tau$ に比例した $\sigma = j\Delta\tau$ の過剰な電荷が界面に蓄積される。つまり、界面は過剰な電荷が蓄積される場所である。そして、この電荷量を適切に制御すればデバイスとしての機能が発現できる（例えばトランジスタ動作^{2,3)}）。その一方、この電荷蓄積は空間電荷電界の源ともなるから、デバイス動作に決定的に影響を及ぼす場合もある（有機太陽電池^{8~10)}、有機ELなど^{11~18)}）。ところで、第1章で述べたように、EFISHG測定では移動するキャリアの作る電界や界面に蓄積した電荷が作る電界に目を向けることが必要となる。言い換えると、マックスウェル・ワグナー効果によって発生する界面蓄積電荷を追跡することは、EFISHG法を用いてデバイス内のキャリア挙動を解析する上で重要ということである。そこで、第3章では、筆者らの開発したEFISHG測定装置と太陽電池材料を用いたFET構造素子の評価例を、界面電荷に着目しながら具体的に示すことにする。

3. EFISHG法によるキャリア挙動の評価

3.1 EFISHG測定装置

EFISHG測定ではレーザー光を照射して有機材料中のキャリアのつくる電界 $E(0)$ を直接測定する。図2にFET型素子のEFISHG測定系とレーザー光の照射タイミングを示す。材料によりEFISHG光を発生する波長が異なるため、光パラメトリック発振器によりレーザー光の波長を変換する。有機FETにおいては垂直入射条件でSHGを測定するため、電界の面内成分が選択的に検出される^{6,7)}。一方で、有機太陽電池では縦方向（膜法線方向）の電界を検出するため、斜入射 p - p 偏光条件で測定を行う^{8,9)}。

FET構造素子のソース電極とドレイン電極を平行に配置すると、キャリアはソース電極か

らシート状に注入し、ドレイン電極へ向かって移動する。EFISHG法を用いるとこの様子を直接可視化することができる。図3(a)に示すように、有機太陽電池に用いられるドナー材料(PCDTBT)の中を正孔が輸送される様子や、アクセプター材料中を電子が輸送される様子がわかる¹⁹⁾。FET型素子では、ソース電極から注入されたキャリアは、電極端からの距離を x として $x = \sqrt{2\mu V_{gs} t}$ (μ :ドリフト移動度)の時間依存性で伝搬していく^{20,21)}(図3(b))。この関係からEFISHG法を用いて求めた移動度は注入の様子には左右されない。そのため、eTOF^{22,23)}などの電流計測による移動度の測定法と併用すれば、キャリアの注入機構や輸送機構などを明確化できる。また、材料内にトラップ準位がある場合には、注入したキャリアがトラップ準位を埋めながらチャンネル中を伝搬する様子もわかる^{6,7)}。図4にはドナー分子(pentacene)とアクセプター分子(C60)を2層積層したFET型素子についての測定例を示す。ここでも、積層膜中の特定の分子層の電界を選択的に測定するために、レーザー光波長を適切に選択することが重要となる^{24,25)}。ソース電極を基準として正のゲート電圧を加えると、ソース電極とドレイン電極から電子が注入する。これに対応してEFISHG測定にはソース電極(S)およびドレイン電極(D)から注入した電子がチャンネルを伝搬していく様子がはっきりと現れる[図4(c), (h)]。特に、C60分子からのEFISHG(レーザー波長1000 nm)が大きく、pentacene分子からのEFISHG(レーザー波長1120 nm)は小さい。このことから、注入した電子は、輸送パスとしてC60/PMMA界面を優先的に選んで伝搬していることがわかる。またEFISHG光強度の分布は、キャリアが均一にFETチャンネル中に広がる場合に特徴的な形をしている。このことから、C60/PMMA界面では電子はトラップされずにスムーズに輸送されていることもわかる。このように、ゲート電圧を変えて電子および正孔の注入を制御し、それぞれのキャリアが優先的に選ぶ輸送パスを明確にし、キャリアに対する輸送パスのトラップの効果などをはっきりと知ることができる。

3.2 有機太陽電池材料の評価の例

太陽電池はドナー分子とアクセプター分子を平行平板電極でサンドイッチした構造(MIM

構造) が基本である。図 5(a)に積層型太陽電池の構造を示した。まず、ドナー分子とアクセプター分子が光を吸収してエキシトンが発生する。これがドナー・アクセプター界面に拡散してエネルギー準位の差により電子と正孔に分離し、それぞれアクセプター層、ドナー層を輸送されて電極に取り出されて光起電力効果が生じる²⁶⁾。このようにして取り出すことができる有機太陽電池の開放電圧 V_{oc} は理想的には次式のように発生するとされている。

$$V_{oc} = \frac{h\nu}{q} - \Delta E - \frac{q}{4\pi\epsilon_s\epsilon_0r_0} \quad (4)$$

第 1 項はドナー分子とアクセプター分子が吸収した光のエネルギーである。第 2 項はキャリアを分離する過程で使われるエネルギーで、通常、ドナー分子とアクセプター分子の LUMO および HOMO 準位のエネルギー差に相当する。第 3 項はエキシトンを電子・正孔に分離するために必要な静電エネルギーである。

一方、外部量子効率 η_{EQE} は次式で与えられる。

$$\eta_{EQE} = \eta_a \cdot \eta_d \cdot \eta_{CT} \cdot \eta_{CC} \quad (5)$$

η_a は光が吸収されてエキシトンが発生する割合、 η_d は発生したエキシトンがドナー・アクセプター界面まで拡散する割合、 η_{CT} はエキシトンが電子と正孔に分離する割合、 η_{CC} は分離したキャリアが電極に取り出される割合である。EFISHG 法を用いれば、キャリアが分離し輸送されて光起電力が発生する過程や、発生したキャリアが再結合などにより消滅する時間(キャリアライフタイム)を直接評価し、それぞれのキャリア過程から光起電力効果を議論できる。

2層積層太陽電池(IZO/pentacene/C60/A1)のEFISHG測定系の概略を図6に、測定例を図7に示す²⁷⁾。また、pentacene分子とC60分子のEFISHGスペクトルと吸収スペクトルを図8に示す。Pentacene分子とC60分子は、異なるエネルギーギャップをもつことを反映して材料固有の吸収スペクトルをもつ。EFISHG光も、レーザー光の波長がエネルギーギャップに対応する波長の2倍の波長であるとき共鳴現象が生じて強く発生するため、材料ごとに異なるEFISHGスペクトルとなる。

積層膜型太陽電池では、ドナー・アクセプター界面で分離した正孔と電子はドナー分子層

とアクセプター分子層を反対方向に輸送されて外部回路に取り出される。太陽電池を開回路として光励起した場合にキャリア挙動を時間分解測定すると[図 7(a), open circuit]、光吸収により発生したエキシトンが pentacene/C60 界面で分離し、輸送時間 t_r で電極に到達して開放電圧 V_{oc} に相当する光起電力が生じる過程を直接測定できる。一方で、太陽電池を短絡して測定した場合には[図 7(b), short circuit]、キャリアが輸送時間 t_r で電極に到達し、その後で界面に過剰なキャリアが蓄積するため電界が変化していくことがわかる(図中の E_s)。このような過剰なキャリアの蓄積は、分離したキャリアが全て取り出されていないことを示しており、外部量子効率[(5)式]のうちキャリアの取り出し効率 η_{cc} を下げる。さらに、界面に蓄積した電子は pentacene/C60 界面にポテンシャルを形成するため、正孔を電極に取り出すためには(4)式の理想状態の開放電圧に加えて、静電エネルギー $\Delta W = qC_1/(C_1 + C_2)$ (C_1 , C_2 , pentacene 層, C60 層のキャパシタンス)に相当するエネルギーが失われることも開放電圧低下の原因となることがわかる。このように、EFISHG 法を用いれば、キャリア蓄積による開放電圧の低下についても評価できる。第 1 章で述べたように、シリコンなどの材料は誘電緩和時間が短く、キャリアは直ちに電極に拡散するため蓄積しない。一方で、有機太陽電池では有機材料が比較的大きな緩和時間をもつため、キャリアが蓄積しやすい。このため、有機太陽電池では、界面に蓄積したキャリアを原因とする開放電圧や短絡光電流への影響を検討することが、太陽電池特性の改善や長寿命化のために重要である。EFISHG 法による測定は、こうした原因の探索に有効である²⁸⁻³³⁾。図 9 は太陽電池の効率改善に用いられる B C P 層の効果を EFISHG 法で測定したものであり、内部電界の反転などを明確に議論できる²⁸⁾。また、高効率化の研究が活発化しているバルクヘテロ型太陽電池についても、EFISHG 法の波長選択性を利用して評価することができる。すなわち、図 10 のようにドナー分子およびアクセプター分子中のキャリア挙動を分離して測定することで、バルクヘテロ層構造と太陽電池特性との関係を明らかにできる³⁴⁾。ここで述べた手法はペロブスカイト型太陽電池などの新しい太陽電池についても応用可能である。

4. 結び

太陽電池などの有機デバイスでは電極-有機界面や異種有機分子界面がデバイス機能発現の源である。そして、これらの界面はキャリアが蓄積しやすい場であり、キャリアを起点として電界が発生する場であることを述べた。EFISHG法では、このキャリアのつくる電界を光学的に計測できる特徴を活かして、キャリアを取り出すための内部電界や、光照射により発生したキャリアのダイナミクスを直接評価することができる。なお、軸対称レーザー光による顕微EFISHG測定系を用いれば、太陽電池の膜厚方向の電界やキャリア挙動の面内分布をマッピングすることができる³⁵⁾。また、フェムト秒レーザーを用いれば、有機太陽電池のみならず、より高速にキャリアが移動する無機系太陽電池でもキャリア挙動評価が可能である³⁶⁾。

謝辞

本研究の一部は日本学術振興会科学研究費(基盤研究(S)22226007, 基盤研究(B)24360118, 若手研究(A)25709022)および科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発プログラムの援助を得て実施された。

文 献

- 1) 岩本光正, 間中孝彰: “SHGを用いた有機エレクトロニクスデバイスのキャリアダイナミクス解析”, 応用物理, **82** (2013) 487-492.
- 2) 岩本光正, 間中孝彰, 林銀珠, 田村亮祐: “有機半導体/絶縁体界面の電荷蓄積とキャリア輸送”, 表面科学, **29** (2008) 105-113; 岩本光正, 間中孝彰: “有機電界効果トランジスタのキャリア挙動解析”, 表面科学, **33** (2012) 75-80.
- 3) 工藤一浩, 大森裕, 岩本光正: “有機エレクトロニクスの技術進展と展望”, 電子情報通

信学会論文誌C, **J92-C** (2009) 488-497.

- 4) M. Iwamoto, T. Manaka, T. Yamamoto and E. Lim: "Probing motion of electric dipoles and carriers in organic monolayers by Maxwell displacement current and optical second harmonic generation," *Thin Solid Films*, **517** (2008) 1312-1316.
- 5) T. Manaka, E. Lim, R. Tamura and M. Iwamoto: "Direct imaging of carrier motion in organic transistors by optical second-harmonic generation," *Nature Photon.*, **1** (2007) 581-584.
- 6) M. Iwamoto, T. Manaka, M. Weis and D. Taguchi: "Probing and modeling of interfacial carrier motion in organic devices by optical second harmonic generation," *J. Vac. Sci. Technol. B*, **28** (2010) C5F12-C5F16.
- 7) M. Iwamoto, T. Manaka and D. Taguchi: "(Invited review paper) Probing and modeling of carrier motion in organic devices by electric-field-induced optical second-harmonic generation," *Jpn. J. Appl. Phys.*, **53** (2014) 100101/1-11.
- 8) D. Taguchi, T. Shino, L. Zhang, J. Li, M. Weis, T. Manaka and M. Iwamoto: "Direct probing of photovoltaic effect generated in double-layer organic solar cell by electric-field-induced optical second-harmonic generation," *Appl. Phys. Express*, **4** (2011) 021602/1-3.
- 9) D. Taguchi, T. Shino, X. Chen, L. Zhang, J. Li, M. Weis, T. Manaka and M. Iwamoto: "Analyzing carrier lifetime of double-layer organic solar cells by using optical electric-field-induced second-harmonic generation measurement," *Appl. Phys. Lett.*, **98** (2011) 133507/1-3.
- 10) D. Taguchi, T. Shino, X. Chen, L. Zhang, J. Li, M. Weis, T. Manaka and M. Iwamoto: "Analyzing photovoltaic effect of double-layer organic solar cells as a Maxwell-Wagner effect system by optical electric-field-induced second-harmonic generation measurement", *J. Appl. Phys.*, **110** (2011) 103717/1-6.
- 11) D. Taguchi, M. Weis, T. Manaka and M. Iwamoto: "Probing of carrier behavior in organic electroluminescent diode using electric field induced optical second-harmonic generation measurement," *Appl. Phys. Lett.*, **95** (2009) 263310/1-263310/3.

- 12) D. Taguchi, L. Zhang, J. Li, M. Weis, T. Manaka and M. Iwamoto: "Analysis of carrier transients in double-layer organic light-emitting diodes by electric-field-induced second-harmonic generation measurement," *J. Phys. Chem. C*, **114** (2010) 15136-15140.
- 13) D. Taguchi, S. Inoue, L. Zhang, J. Li, M. Weis, T. Manaka and M. Iwamoto: "Analysis of organic light-emitting diode as a Maxwell-Wagner effect element by time-resolved optical second-harmonic generation measurement," *J. Phys. Chem. Lett.*, **1** (2010) 803-807.
- 14) D. Taguchi, L. Zhang, J. Li, M. Weis, T. Manaka and M. Iwamoto: "Direct probing of carrier behavior in electroluminescence indium-zinc-oxide/N,N'-Di-[(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl]-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine/Tris(8-hydroxy-quinolinato)aluminum(III)/LiF/Al Diode by time-resolved optical second-harmonic generation," *Jpn. J. Appl. Phys.*, **50** (2011) 04DK08/1-5.
- 15) D. Taguchi, R. Nakamoto, T. Manaka and M. Iwamoto: "Detection of pre-electrical breakdown of IZO/ α -NPD/Alq3/Al light-emitting diodes by electric-field-induced optical second-harmonic generation measurement," *Jpn. J. Appl. Phys.*, **53** (2014) 04EK02/1-4.
- 16) A. Sadakata, K. Osada, D. Taguchi, T. Yamamoto, M. Fukuzawa, T. Manaka and M. Iwamoto: "Probing interfacial charge accumulation in ITO/ α -NPD/Alq3/Al diodes under two electroluminescence operational modes by electric-field induced optical second-harmonic generation," *J. Appl. Phys.*, **112** (2012) 083723/1-8.
- 17) A. Sadakata, K. Osada, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "Probing space charge effect on electroluminescence of indium tin oxide (ITO)/N,N'-di-[(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl]-(1,1'-biphenyl)-4, 4'-diamine (α -NPD)/tris(8-hydroxy-quinolinato) aluminum (III) (Alq3)/Al diodes by time-resolved electric-field-induced optical second-harmonic generation measurement," *Thin Solid Films*, **554** (2014) 110-113.
- 18) Y. Mashiko, D. Taguchi, M. Weis, T. Manaka and M. Iwamoto: "The Maxwell-Wagner model for

charge transport in ambipolar organic field effect transistors: The role of zero-potential position," *Appl. Phys. Lett.*, **101** (2012) 243302/1-4.

- 19) Z. Ahmad, S. M. Abdullah, D. Taguchi, K. Sulaiman, T. Manaka and M. Iwamoto: "Investigation of carrier transit motion in PCDTBT by optical SHG technique," *Laser Physics*, **24** (2014) 105701.
- 20) T. Manaka, F. Liu, M. Weis and M. Iwamoto: "Diffusionlike electric-field migration in the channel of organic field-effect transistors," *Phys. Rev. B*, **78** (2008) 121302/1-4.
- 21) M. Weis, J. Lin, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "The charge transport in organic field-effect transistor as an interface charge propagation: The Maxwell-Wagner effect model and transmission line approximation," *Jpn. J. Appl. Phys.*, **49** (2010) 071603/1-8.
- 22) J. Lin, M. Weis, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "Carrier propagation dependence on applied potentials in pentacene organic field effect transistors investigated by impedance spectroscopy and electrical time-of-flight techniques," *Jpn. J. Appl. Phys.*, **50** (2011) 04DK01/1-4.
- 23) M. Weis, J. Lin, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "Analysis of transient currents in organic field effect transistor: The time-of-flight method," *J. Phys. Chem. C*, **113** (2009) 18459-18461.
- 24) Y. Shibata, M. Nakao, T. Manaka, E. Lim and M. Iwamoto: "Probing electric field distribution in underlayer of an organic double-layer system by optical second-harmonic generation measurement," *Jpn. J. Appl. Phys.*, **48** (2009) 021504/1-5.
- 25) L. Zhang: "*Analysis of carrier behaviours in organic diodes and transistors by using electric field induced optical second harmonic generation and charge modulation spectroscopy*," 学位論文, 東京工業大学, 2013. 第5章.松尾豊: 有機薄膜太陽電池の科学 (化学同人, 2011) .
- 26) X. Chen, D. Taguchi, K. Lee, T. Manaka and M. Iwamoto: "Analyzing interfacial carrier charging in pentacene/C60 double-layer organic solar cells by optical electric field induced second-harmonic generation measurement," *Chem. Phys. Lett.*, **511** (2011) 491-495. X. Chen, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "Analyzing photo-induced interfacial charging in IZO/pentacene/C60/bathocuproine/Al organic solar cells by electric-field-induced optical

- second-harmonic generation measurement," *J. Appl. Phys.*, **111** (2012) 113711/1-6.
- 27) X. Chen, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "Interfacial charging originated from the conductivity decrease of C60 layer in IZO/pentacene/C60/Al organic double-layer solar cells," *Org. Electron.*, **15** (2013) 162-168.
- 28) X. Chen, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "Study of multiple photovoltaic processes in stacked organic active layers," *Org. Electron.*, **15** (2014) 2014-2020.
- 29) X. Chen, D. Taguchi, K. Lee, T. Manaka and M. Iwamoto: "Analysis of interfacial charging process in pentacene/C60/bathocuproine triple-layer organic solar cells using a Maxwell-Wagner model", *Jpn. J. Appl. Phys.*, **52** (2013) 04CR05/1-5.
- 30) X. Chen, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "Study of blocking effect of Cu-phthalocyanine layer in zinc oxide/pentacene/CuPc/C60/Al organic solar cells by electric field-induced optical second harmonic generation measurement," *Org. Electron.*, **14** (2012) 320-325.
- 31) D. Taguchi, R. Sumiyoshi, X. Chen, T. Manaka and M. Iwamoto: "Study of interface layer effect in organic solar cells by electric-field-induced optical second-harmonic generation measurement," *Thin Solid Films*, **554** (2014) 51-53.
- 32) X. Chen, D. Taguchi, T. Manaka and M. Iwamoto: "Selective observation of photo-induced electric fields inside different material components in bulk-heterojunction organic solar cells," *Appl. Phys. Lett.*, **104** (2014) 013306/1-5.
- 33) D. Taguchi, T. Manaka, M. Iwamoto, T. Karasuda and M. Kyomasu: "A novel microscope for visualizing electric fields in organic thin film devices using electric-field-induced second-harmonic generation," *Jpn. J. Appl. Phys.*, **52** (2013) 04CK04/1-3.
- 34) W. Ou-yang, T. Manaka, S. Naitou, K. Kunitomo and M. Iwamoto: "Optical second-harmonic generation in hydrogenated amorphous silicon single- and double-junction solar cells," *Jpn. J. Appl. Phys.*, **51** (2012) 070209/1-3.

図題

- 図 1 EFISHG 光の発生とキャリアのつくる静電界 $E(0)$ による電子雲のひずみ。
- 図 2 (a)EFISHG 測定系 (b)時間分解測定における電圧印加とレーザーパルス入射のタイミングチャート。
- 図 3 (a) FET 構造素子を用いた太陽電池材料(PCDTBT)のキャリア輸送の様子を EFISHG 測定により可視化した測定例。正孔がソース電極から注入し、輸送される様子が EFISHG 光の移動として可視化されている。(b)正孔輸送の $x-\sqrt{t}$ プロット。傾きからドリフト移動度 μ を評価できる。文献¹⁹⁾より許可を得て転載。© 2014 Astro Ltd. Reproduced by permission of IOP Publishing. All rights reserved
- 図 4 2層積層 FET トランジスタ (pentacene/C60/PMMA/SiO₂) の評価例。(a)測定系の概略。(b)EFISHG イメージング測定例。(c-g) レーザー波長 1000 nm (EFISHG 波長 500 nm) での時間分解測定結果。C60 層のキャリア挙動を選択的に測定している。(h-1) レーザー波長 1120 nm (EFISHG 波長 560 nm) での時間分解測定結果。Pentacene 層のキャリア挙動を選択的に測定している。(m-q) キャリア挙動の様子。張樂博士の許可を得て転載²⁵⁾。
- 図 5 (a)積層構造型および(b)バルクヘテロ型太陽電池。
- 図 6 太陽電池デバイス用 EFISHG 測定系。
- 図 7 積層型有機太陽電池 (IZO/pentacene/C60/Al) の EFISHG 測定の例。文献²⁷⁾より許可を得て転載。© 2011 Elsevier B. V.
- 図 8 pentacene および C60 の吸収スペクトル(a)と EFISHG スペクトル(b)。
- 図 9 BCP 層のない場合 (double-layer) とある場合 (triple-layer) の太陽電池 (IZO/pentacene/C60/BCP/Al) の光照射による時間分解 EFISHG の測定結果。文献²⁸⁾より許可を得て転載。© 2012 AIP Publishing LLC.
- 図10 バルクヘテロ型太陽電池 (IZO/pentacene:C60/Al) のEFISHG測定の例。文献³⁴⁾より許可を

得て転載。© 2014 AIP Publishing LLC.

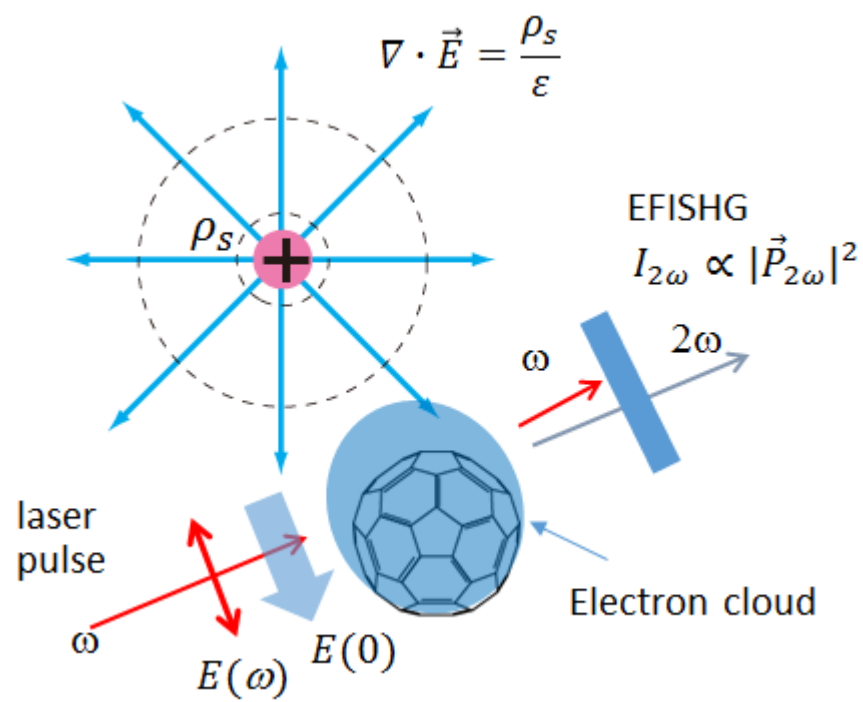


图1 田口・間中・岩本

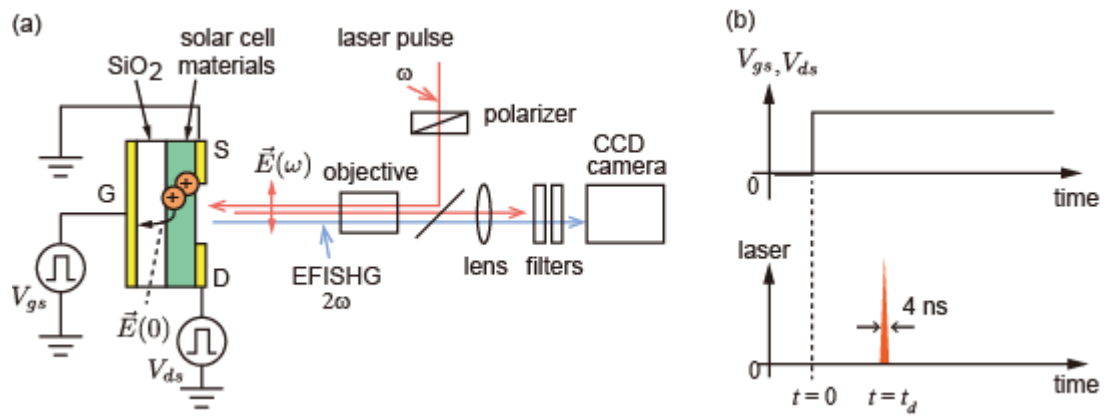


图2 田口・間中・岩本

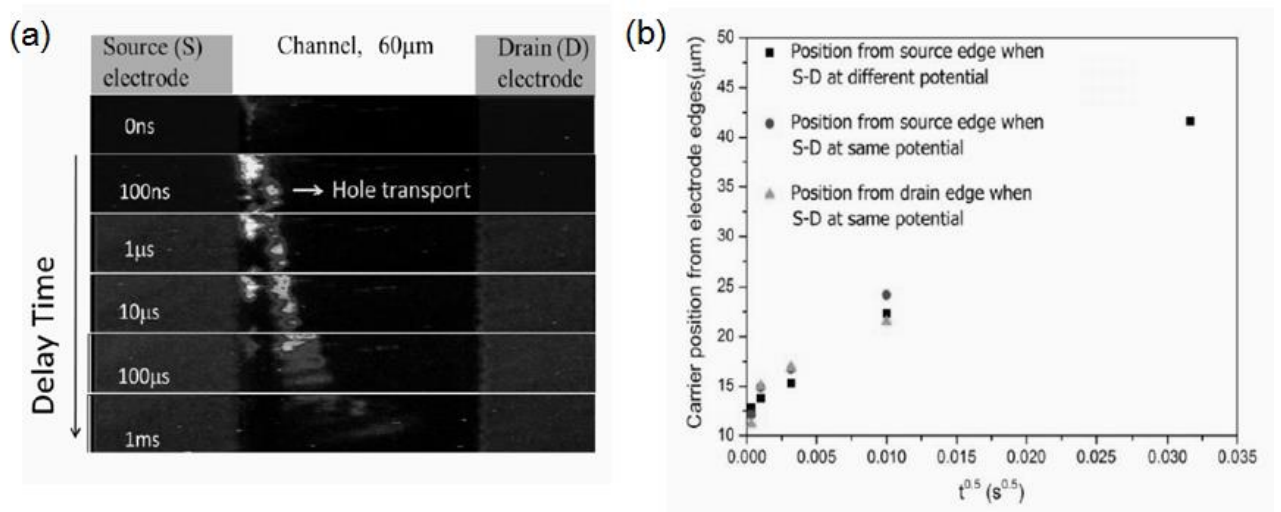


図3 田口・間中・岩本

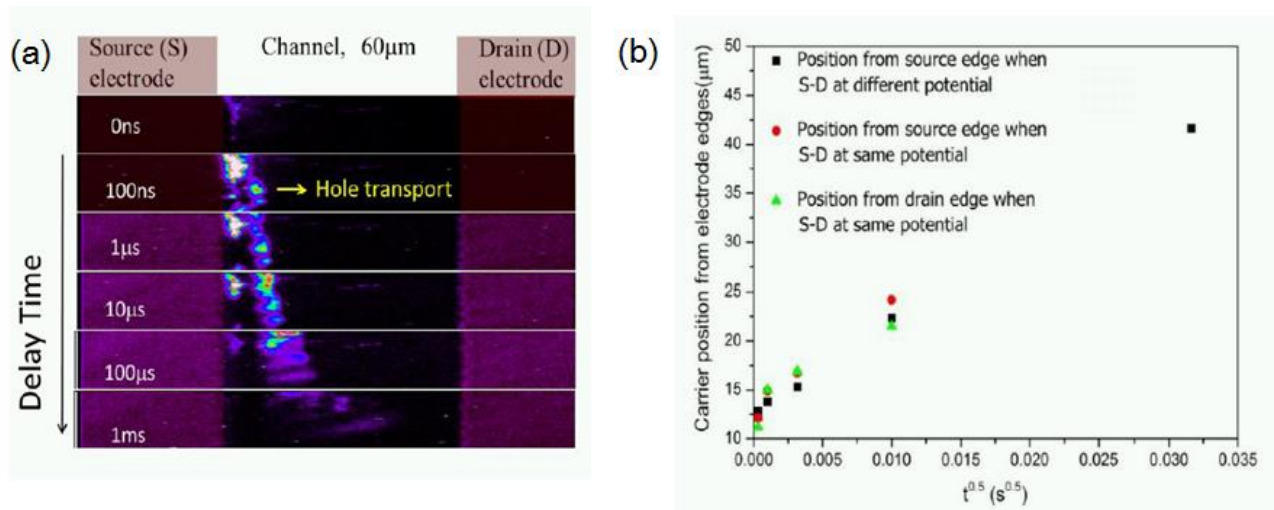


図 3 (学会HP用カラー原稿) 田口・間中・岩本

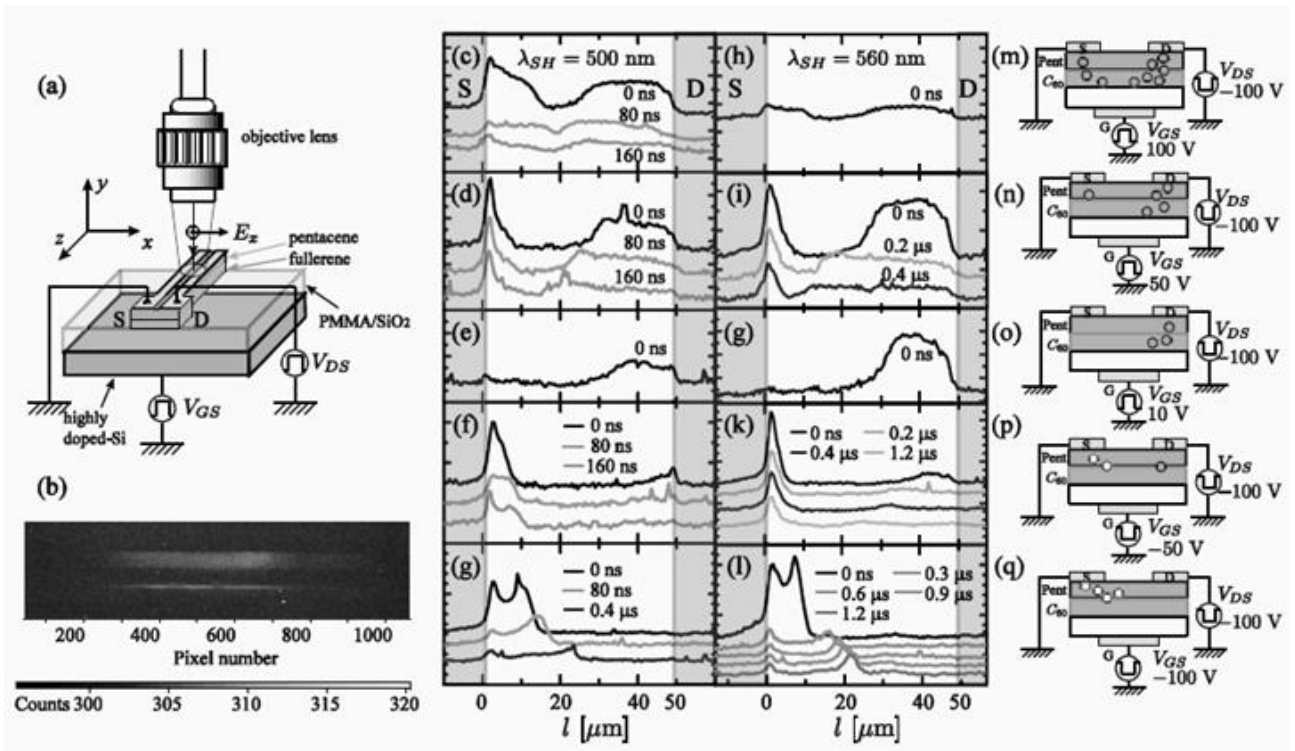


图4 田口・間中・岩本

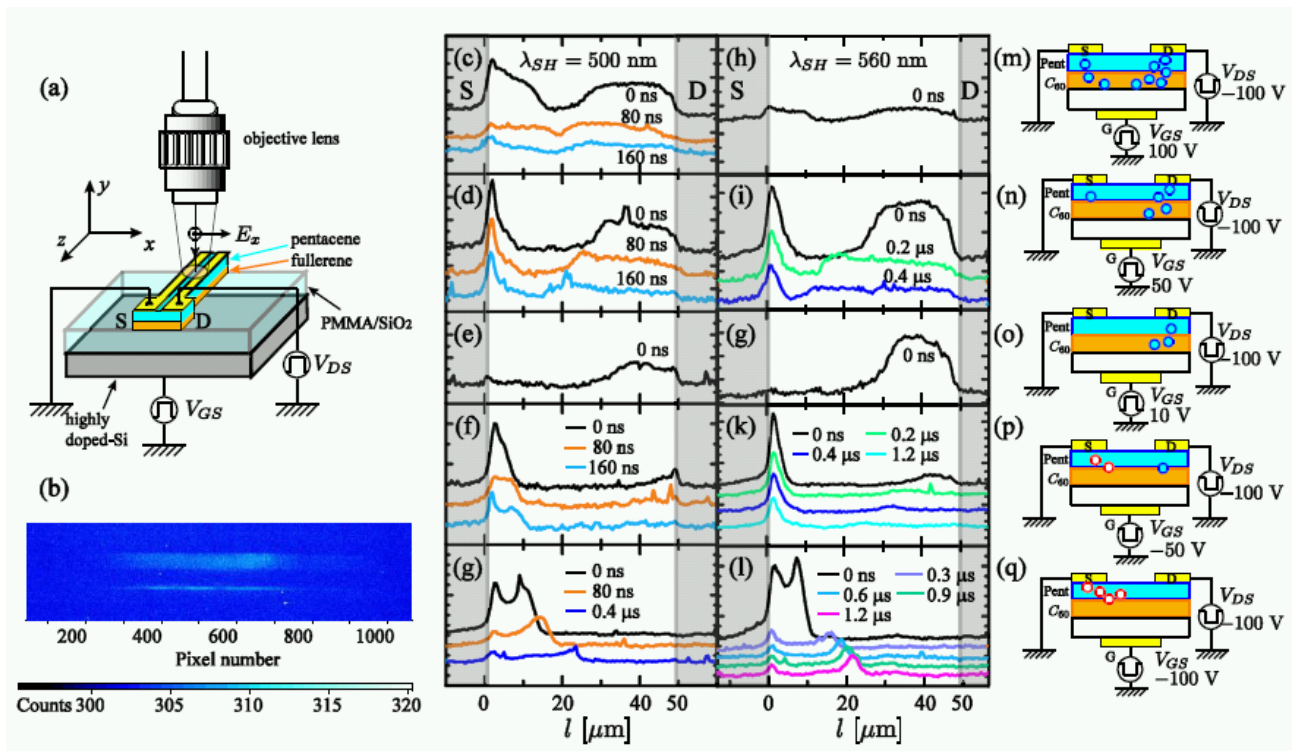


図 4 (学会HP用カラー原稿) 田口・間中・岩本

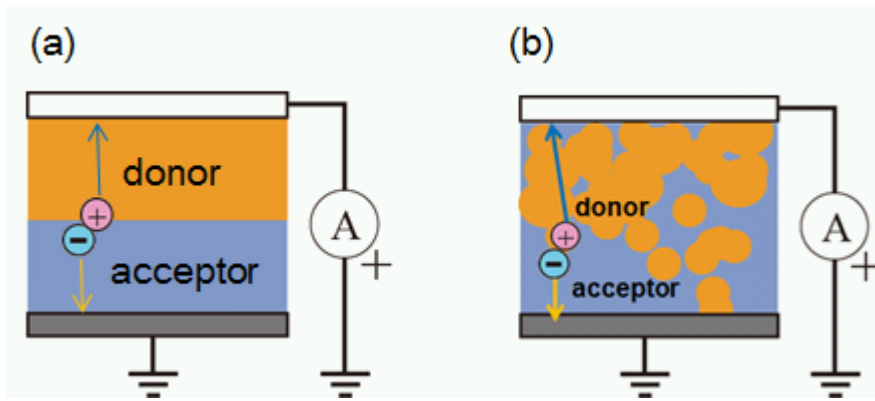


图5 田口・間中・岩本

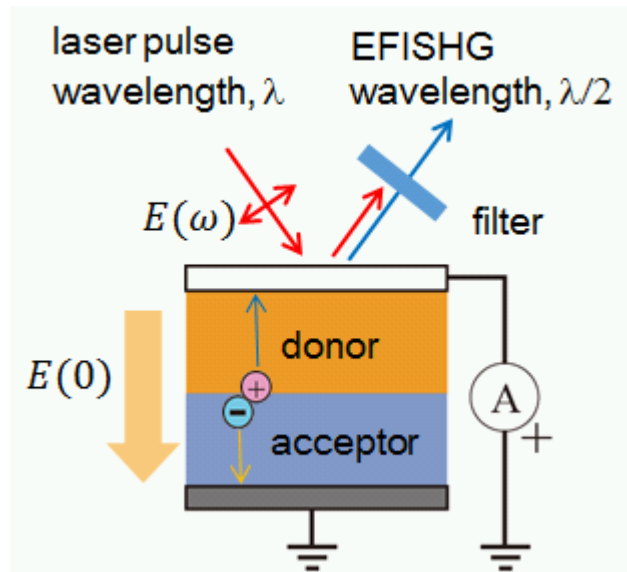


图6 田口・間中・岩本

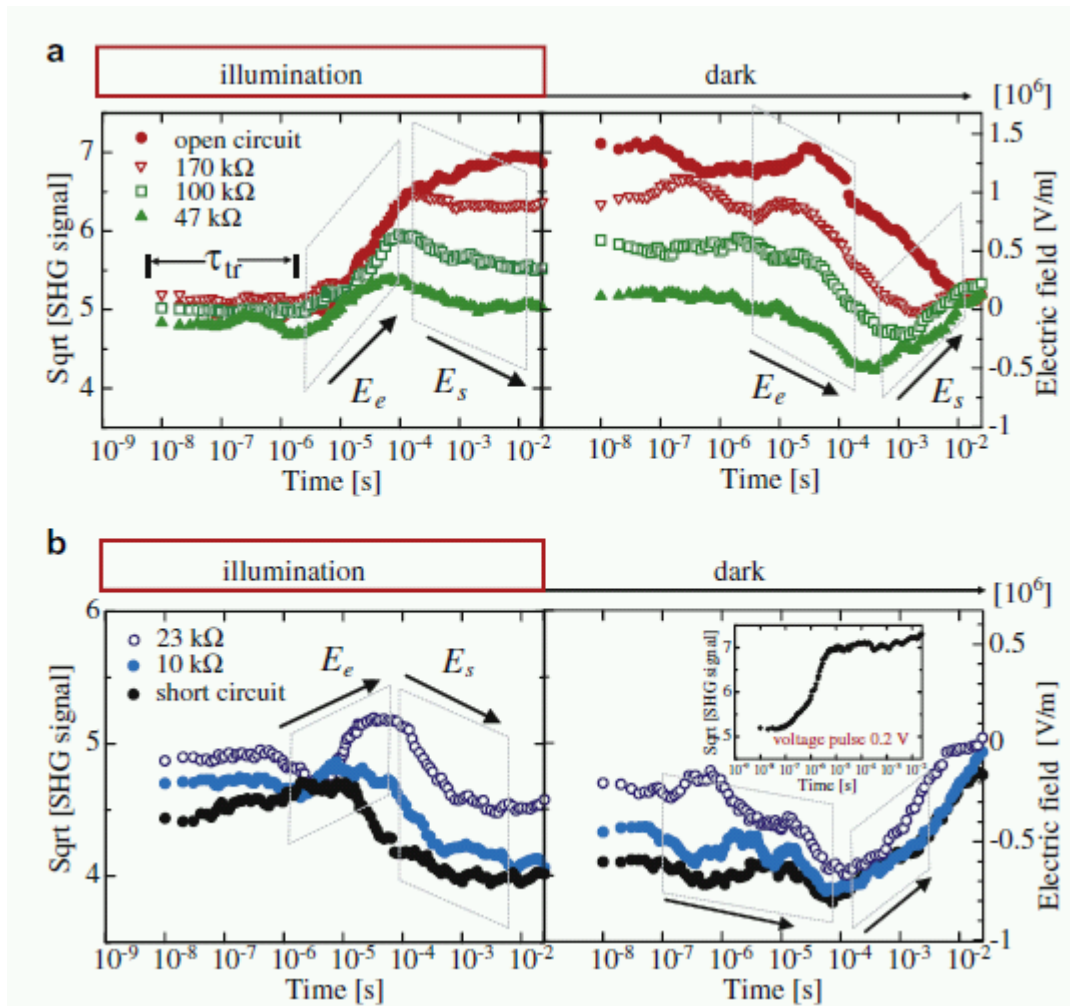


図7 田口・間中・岩本

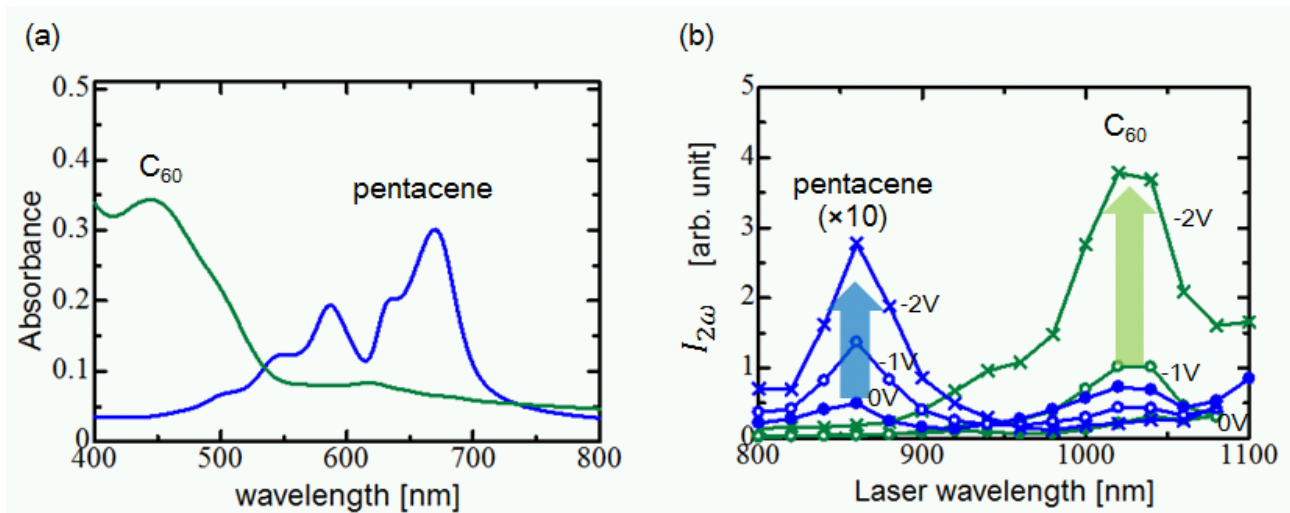


図8 田口・間中・岩本

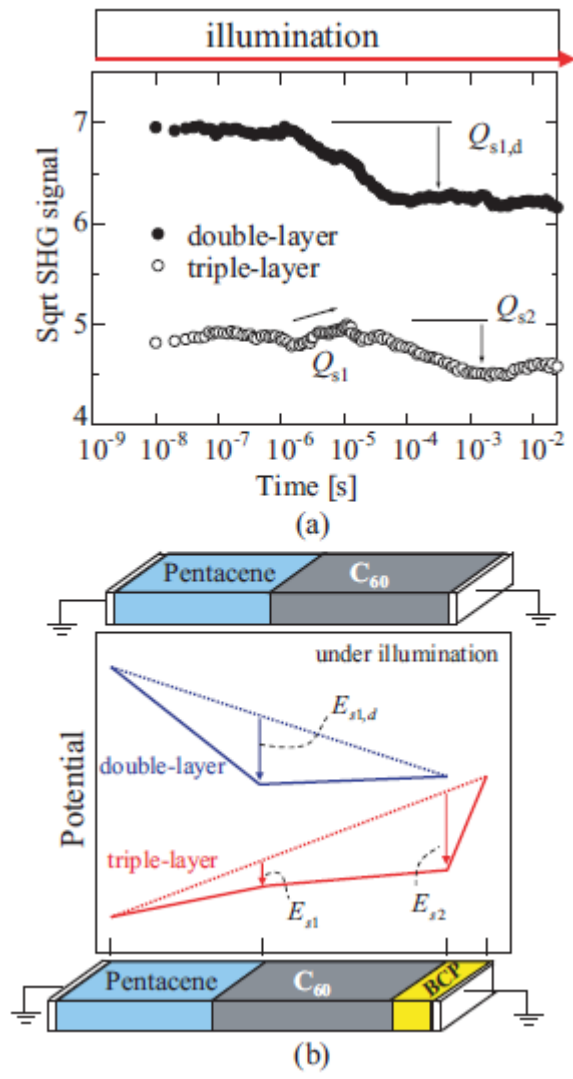


图9 田口・間中・岩本

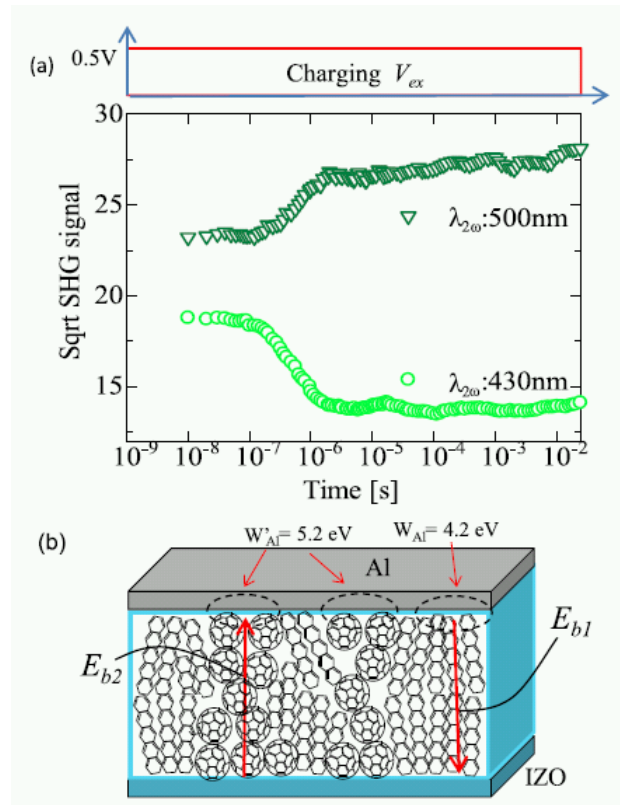


图 10 田口・間中・岩本